



دانشگاه صنعتی شیراز

دانشکده مهندسی و علم مواد، گروه الکتروسرامیک

پایان نامه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی مواد

رسوب دهی الکتروفورتیک نانوذرات TiO_2 به منظور ساخت فتوآند

نانوساختار در سلول های خورشیدی حساس شده با رنگینه

بوسیله:

مهدیه سلمانی

استاد راهنما:

دکتر علی مشرقی

آبان ماه ۱۳۹۲



الله الرحمن الرحيم
الله العظيم الرحمن الرحيم
الله الصمد لا شريك له
لله الصلوة والحمد وال谢
لا يعذل عذله ولا يغفر عذره
الله عز وجل عالم المصون
الله عز وجل عالم المصون
فلا إله إلا الله

بسمه تعالیٰ

رسوب دهی الکتروفورتیک نانوذرات TiO_2 به منظور ساخت فتوآند نانوساختار در سلول های خورشیدی حساس شده با رنگینه

پایان نامه ارائه شده به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی

توسط:

مهدیه سلمانی

برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

گروه الکتروسرامیک، دانشکده مهندسی و علم مواد

دانشگاه صنعتی شیراز

ارزیابی شده توسط کمیته پایان نامه با درجه: عالی

دکتر علی مشرقی، استادیار مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شیراز (استاد راهنمای).....

دکتر هومان شکرالله‌ی، استادیار مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شیراز (استاد مشاور).

دکتر مرتضی علیزاده، استادیار مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شیراز (استاد داور).

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه :

حق چاپ محفوظ و مخصوص به دانشگاه صنعتی شیراز است.

تأییدیه‌ی صحت و اصالت نتایج

اینجانبمهدیه سلمانیدانشجوی رشته مهندسی مواد-الکتروسرامیکمقطع تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره دانشجویی ۱۶۴۰۲۹۰ تأیید می نماید کلیه نتایج این پایان نامه ، بدون هیچگونه دخل و تصرف ، حاصل مستقیم پژوهش صورت گرفته توسط اینجانب است. در مورد اقتباس مستقیم و غیر مستقیم از سایر آثار علمی، اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه با رعایت امانت و اخلاق علمی، مشخصات کامل منبع مذکور درج شده است.

در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخیص مقامات ذی صلاح دانشگاه صنعتی شیراز، مطابق قوانین و مقررات مربوط و آئین نامه های آموزشی، پژوهشی و انضباطی عمل خواهد شد و اینجانب حق هرگونه اعتراض و تجدیدنظر را، نسبت به رأی صادره، از خود ساقط می کند. همچنین، هرگونه مسئولیت ناشی از تخلف نسبت به صحت و اصالت نتایج مندرج در پایان نامه/رساله در برابر اشخاص ذی نفع (اعم از حقیقی و حقوقی) و مراجع ذی صلاح (اعم از اداری و قضایی) متوجه اینجانب خواهد بود و دانشگاه صنعتی شیراز هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

تبصره ۱- کلیه حقوق مادی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شیراز است.

تبصره ۲- اینجانب تعهد می نماید بدون اخذ مجوز از دانشگاه صنعتی شیراز دستاوردهای این پایان نامه/رساله را منتشر نکند و یا در اختیار دیگران قرار ندهد.

نام و نام خانوادگی دانشجو:

تاریخ و امضاء

مجوز بهره‌برداری از پایان‌نامه

کلیه حقوق مادی و معنوی مترتب بر نتایج پایان نامه متعلق به دانشگاه و انتشار نتایج نیز تابع مقررات دانشگاهی است و با موافقت استاد راهنما به شرح زیر، بلامانع است:

- بهره‌برداری از این پایان‌نامه/رساله برای همگان بلامانع است.
- بهره‌برداری از این پایان‌نامه/رساله با اخذ مجوز از استاد راهنما، بلامانع است.
- بهره‌برداری از این پایان‌نامه/رساله تا تاریخ ممنوع است.

نام استاد یا اساتید راهنما:

تاریخ:

امضا:

تقدیم به

مادر و پدری از جنس
زیبایی

و

خواهری از رنگ پرواز

سپاسگزاری:

به نام پروردگار یکتا
سپاس آن بی همتایی که مانند همیشه با الطاف بی پایانش در انجام و به پایان رساندن این رساله مرا یاری نمود.
او را سپاس می گوییم که مرا لایق آموختن گردانید.
رهنمودهای بی دریغ و ارزنده اساتید بزرگوارم که هدایت این رساله را به عهده داشتند مرا بر آن می دارد که با
این جملات کوتاه و ناکافی سپاسگزاری خود را از این بزرگواران بیان کنم.

با تشکر از یاوران همیشگی ام

مادرم

و

پدرم

و خواهرم و برادرانم

با تشکر از مشوقان واقعی راه علم

استاد ارجمند جناب آقای دکتر مشرقی،

استاد گرانقدر جناب آقای دکتر علیزاده

استاد گرامی جناب آقای دکتر شکراللهی

جناب آقای دکتر سلطانی راد بخاطر راهنمایی و مساعدت ایشان برای تست های فراصوت

جناب آقای مهندس چمن باز

و همچنین از بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بخاطر حمایت های مالی این
پژوهش سپاسگذاری و قدردانی می گردد.

چکیده

رسوب‌دهی الکتروفورتیک نانوذرات TiO_2 به منظور ساخت فتوآند نانوساختار در سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگینه

به وسیله‌ی:

مهدیه سلمانی

این پژوهش با هدف ساخت لایه‌های نانومتلخلخل TiO_2 با روش رسوب‌دهی الکتروفورتیک و استفاده از آن به عنوان فتوآند در سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه انجام شد. فتوآند نیمه‌هادی حساس شده با رنگینه، نقش مهمی در تبدیل فوتون‌ها به انرژی الکتریکی ایفا می‌کند. به منظور رسیدن به سلول‌هایی با بازدهی بالا، تهیه الکترود با مساحت سطحی بالا که به جذب رنگینه کافی منتهی شود، الزامی است. یک روش موثر برای کنترل تخلخل، مساحت سطحیو چگالی فیلم، روش رسوب‌دهی الکتروفورتیک است. در این پژوهش یک سوسپانسیون پایدار از نانوذرات TiO_2 ساخته شد و از آن برای لایه نشانی با روش الکتروفورتیک استفاده گردید. در ساخت سوسپانسیون از ایزوپروپیل الکل، نانوذرات TiO_2 ، استیل استون، استون و آب استفاده شد. پس از لایه نشانی نانوذرات TiO_2 روی سطح شیشه شفاف رسانا با روش الکتروفورتیک و عملیات حرارتی، پوشش ساخته شده به عنوان فیلم فتوآند سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه مورد استفاده قرار گرفت. از رنگینه مرکوکروم برای حساس کردن پوشش TiO_2 استفاده شد. منحنی ولتاژ- جریان‌سلول خورشیدی حاصل تحت تابش نور لامپ زنون اندازه‌گیری و محاسبه گردید. سلول ساخته شده با فتوآندی که تحت ولتاژ 30 ولت و به مدت 8 دقیقه الکتروفورتیک گردید، بهترین عملکرد را از خود نشان داد. ضخامت لایه نانومتلخلخل TiO_2 این فتوآند 13 میکرومتر بود. چگالی جریان مدار کوتاه، ولتاژ مدار باز و بازده

این سلول به ترتیب ۰/۹۳ میلی آمپر بر سانتی متر مربع، ۴۵۵ میلی ولت و ۰/۱۸٪ برای این سلول مشاهده گردید.

فهرست مطالب

عنوان	صفحة
۱ مقدمه	۱
۱-۱- پیشگفتار	۲
۲ معرفی بر تحقیقات گذشته	۴
۲-۱- ضرورت وجود استفاده از انرژی های جدید	۵
۲-۱-۱- اهمیت انرژی خورشیدی	۶
۲-۱-۲- موقعیت کشور ایران از نظر میزان دریافت انرژی خورشیدی	۶
۲-۲- تاریخ چه سلول های فتوولتایک	۷
۳-۲- سلول های خورشیدی حساس شده بارنگینه	۹
۳-۲-۱- پیشینه تاریخی	۹
۳-۲-۲- معرفی سلول های خورشیدی حساس شده بارنگینه	۱۰
۴-۲- ساختار و اصول عملکرد سلول خورشیدی حساس شده بارنگینه	۱۱
۴-۲-۱- فرایند تریقالکترون درونیم هر سانا	۱۴
۴-۲-۲- بازتر کی بالکترون	۱۴
۴-۲-۳- باز تولیدرنگینها اکسید شده	۱۵
۴-۴-۲- باز تر کی بالکترون های تریقالکترون دو چفترو دو کسالکترو لیت	۱۶
۴-۴-۲-۵- احیاء جزء اهدا کننده الکترون در الکترو لیت تو سط الکترو دشمار نده	۱۶
۵-۲- اجزاء مختلف سلول خورشیدی حساس شده بارنگینه	۱۷

۱۷.....	زیر لایه.....۱-۵-۲
۱۹.....	فتوالکترود.....۲-۵-۲
۲۰	رنگینه حساس به نور.....۳-۵-۲
۲۱	الکترولیتاکسایشی - کاهشی.....۴-۵-۲
۲۲	الکترود شمارنده.....۵-۵-۲
۲۲.....	روشر سوب دهی الکتروفورتیک.....۶-۲
۲۲.....	ضرور ت استفاده از روشر سوب دهی الکتروفورتیک.....۱-۶-۲
۲۳	معرفی روشر سوب دهی الکتروفورتیک.....۲-۶-۲
۲۵.....	لایهدو گانه یا الکتریکی، پتانسیلر تاوت حر کالکتروفورتیکی.....۳-۶-۲
۲۷	نیروها ییک هبا عثته نشینند ر ادر سوسپانسیون می شوند.....۴-۶-۲
۲۸.....	پارامتر های موثر بر فرایندر سوب دهی الکتروفورتیک.....۵-۶-۲
۲۸.....	پارامتر های مرتبه سوسپانسیون.....۱-۵-۶-۲
۳۰	پارامتر های مرتبه فرایندر.....۲-۵-۶-۲
۳۱	سرعت تشکیل رسوب در فرایندر سوب دهی الکتروفورتیک.....۲-۶-۶
۳۲	مکانیزم های فرایندر سوب دهی الکتروفورتیک.....۷-۶-۲
۳۲	انعقاد راثر تجمع مذرات.....۱-۷-۶-۲
۳۲	مکانیزم مختیشد نبار ذره.....۲-۷-۶-۲
۳۲	مکانیزم مانع قاد الکتروشیمیا ییذره.....۳-۷-۶-۲
۳۳	مکانیزم ماعوجا جو ناز کشدن لایه یدو گانه یا الکتریکی۴-۷-۶-۲

۳۴.....	۷-۲- پارامترهای مهم در منحنی مشخصه جریان - ولتاژ سلول خورشیدی
۳۵.....	۱-۷-۲- جریان مدار کوتاه
۳۵.....	۲-۷-۲- ولتاژ مدار باز
۳۶.....	۳-۷-۲- ولتاژ و جریان بیشینه
۳۶.....	۴-۷-۲- ضربی پر شدگی (انباست)
۳۶.....	۵-۷-۲- بازده تبدیل یوان
۳۷.....	۶-۷-۲- استاندارهای تابش خورشید
۳۸.....	۸-۲- اهداف پیروزه
۳۸.....	۹-۲- دلایل استفاده از مواد بکار رفته در آزمایش
۳۸.....	۱-۹-۲- نانوذرات TiO_2
۳۸.....	۲-۹-۲- الكل (اتانول، ایزوپروپیل الكل)
۳۹.....	۳-۹-۲- استیلاستون
۳۹.....	۴-۹-۲- استون
۳۹.....	۵-۹-۲- ید
۴۰.....	۶-۹-۲- FTO
۴۰.....	۷-۹-۲- هگزاکلروپلاتینیک اسید
۴۰.....	۸-۹-۲- یدید لیتیم
۴۰.....	۹-۹-۲- رنگینه های مرکب و کروم N719
۴۱.....	۳- رو شا آزمایش

۴۲.....	۱-۳-۳- مقدمه
۴۲.....	۲-۳- موادمورداستفاده
۴۳.....	۳-۳- دستگاههایمورداستفاده
۴۳.....	۱-۳-۳- دستگاهتمیزکندهفراصوت
۴۴.....	۲-۳-۳- دستگاههمزنفراصوت
۴۵.....	۳-۳-۳- دستگاهشبیهسازنورخورشید
۴۶.....	۴-۳-۳- کورهایالکتریکی
۴۷.....	۵-۳-۳- ترازو
۴۷.....	۶-۳-۳- همزنمناطیسی
۴۸.....	۷-۳-۳- منبعتعذیه DC
۴۸.....	۸-۳-۳- ریزسنچ
۴۸.....	۹-۳-۳- pH متر
۴۹.....	۱۰-۳-۳- مولتیمتر
۴۹.....	۱۱-۳-۳- دستگاهپولیش
۵۰.....	۱۲-۳-۳- میکروسکوپنوری
۵۰.....	۴-۳- ساختسلولخورشیدیحساسشدهبارنگینه
۵۱.....	۱-۴-۳- ساختفتوا آند
۵۱.....	۱-۴-۳- ساختپوششنانومتخلخل TiO_2
۵۶.....	۱-۴-۳- ۲-۱- حساسکردنپوششنانومتخلخل TiO_2 بارنگینه

۵۶.....	۲-۴-۳ - ساختالکترودشمارنده
۵۷.....	۳-۴-۳ - تهیه يالکتروليتمناسب.
۵۷.....	۴-۴-۳ - مونتاژسلولخورشیديحساسشدهبارنگينه
۵۸.....	۳-۵ - برسيخواصفتولتائيكسلولخورشیديحساسشدهبارنگينه
۵۸.....	۳-۶ - بررسی هايديگر
۵۸.....	۱-۶-۳ - بررسياثرولتازاعمالببرويخواصپوشتشكيلشده
۵۹.....	۲-۶-۳ - بررسياثرزمانانجامواكنشبررويخواصپوشتشكيلشده
۵۹.....	۳-۶-۳ - بررسيتاثيرمقاديرمختلفاببررويخواصميكروساختاريپوشتشكيلشده
۶۰.....	۴-۶-۳ - بررسيتاثيرمقداريدبررويH _p ورنگسوپانسيونوخواصپوشتشكيلشده

۴. نتایجوتحلیلانها

۶۲.....	۴-۱ - برسيدلايممناسبنبودنسوپانسيونهايساختهشده
۶۲.....	۱-۱-۴ - سوپانسيونشماره ۱
۶۲.....	۲-۱-۴ - سوپانسيونشماره ۳
۶۲.....	۲-۴ - بررسياثيريدبرH _p سوپانسيونپوشتشكيلشده
۶۲.....	۱-۲-۴ - اثرييدبرH _p سوپانسيون
۶۳.....	۲-۲-۴ - اثرييدبرمورفولوزيوغضاخامتپوشتشكيلشده
۶۶.....	۳-۴ - بررسياثارآبررويرسانايسوپانسيونورسوبيتشكيلشده
۶۹.....	۴-۴ - رسوبدهيالکتروفورتيکنانوذرات TiO_2
۶۹.....	۱-۴-۴ - مکانيزمايجادرسوبنانوذرات TiO_2

۷۱	- بررسی اثر ولتاژ اعمالیبر روی ضخامت و وزن سوبتاشکیل شده بر روی پوشش	۴-۴-۲
۷۱	- بررسی وزن سوبتاشکیل شده بهولتاژ اعمالی در زمان ثابت	۴-۴-۲-۱
۷۲	- بررسی اثر ولتاژ اعمالی بر ضخامت پوشش های تشکیل شده	۴-۴-۲-۲
۷۳	- بررسی اثر زمان جامو اکنش بر روی ضخامت و وزن سوبتاشکیل شده بر روی سطح	۴-۴-۳-۳
۷۴	- بررسی اثر مدت زمان فرایند الکتروفورتیک بر وزن سوبتاشکیل شده	۴-۴-۳-۱
۷۵	- بررسی اثر مدت زمان فرایند الکتروفورتیک بر ضخامت فیلم های تشکیل شده	۴-۴-۳-۲
۷۶	- بررسی خواص فتوولتائیک سلول لخور شید ی حساس شده بار نگینه	۴-۴-۵
۷۶	- بررسی اثر مدت زمان فرایند الکتروفورتیک بر خواص فتوولتائیک سلول	۴-۵-۱
۸۱	- بررسی خواص میکرو ساختار پوشش ها	۴-۵-۱-۱
۸۴	- بررسی اثر ولتاژ اعمالی بر خواص فتوولتائیک سلول	۴-۵-۲
۸۶	- بررسی اثر نگینه بر خواص فتوولتائیک سلول	۴-۵-۳
		۴-۵-۴
۸۹	بررسی اثر ماندگاری الکترو لیتسلول لخور شید ی حساس شده بار نگینه با گذشت زمان بر خواص فتوولتائیک سلول	
	ل	
۹۲	نتیجه گیری پیشنهادات	۵
۹۳	۱-۵- جمع بندی نتیجه گیری	
۹۵	۲-۵- پیشنهادات	

فهرست جداول

صفحه عنوان و شماره

جدول ۱-۳ - موادبکاررفتهرايساختسوسپانسيوندروروشالكتروفوريك.	۴۲
جدول ۲-۳ - موادمورداستفادههرابساختسولخورشيديحساسىشدهبارنگينه.	۴۳
جدول ۳-۳ - مقاديربكاررفتهدررسوسپانسيون ۱.	۵۱
جدول ۳-۴ - مقاديربكاربردهدررسوسپانسيون ۲.	۵۳
جدول ۳-۵ - مقاديربهينهموادمورداستفادههرساختسوسپانسيون.	۵۴
جدول ۳-۶ - مشخصاتنمونههاياآمادهشددهرولتازمتغيروزمانثابت ۱ ، ۳ و ۸ دقيقه	۵۸
جدول ۳-۷ - مشخصاتنمونههاياآمادهشددهرولتازثابت ۱۰ و ۳۰ ولتوzmanمتغير.	۵۹
جدول ۳-۸ - سوسپانسيون ۷ بامقادير مختلفاب.	۵۹
جدول ۹-۳ - سوسپانسيونها بامقادير مختلفيد.	۶۰
جدول ۱-۴ - مشخصاتالكتريكيسلولخورشيديحاويفتوآندساختهشدهدرزمان ۱ ، ۸،۳ و ۱۲ دقيقه.	۸۳
جدول ۲-۴ - مشخصاتالكتريكيسلولخورشيديحاويفتوآندساختهشدهدرولتاز ۱۰ و ۳۰ ولت.	۸۶
جدول ۳-۴ بازده، ضربيپر شوندگی، ولتازمدار باز و جرياناتصالکوتاه دوسلولخورشيديحاوينگينه مرکرو كروم و	N719
	۸۸

فهرست اشکال

صفحه	عنوان
٨	شكل ۱-۲ - اتصال دونیم هر سانا و <i>o</i> وايجاد منطقه هتھياز بار
۱۱	شكل ۲-۲ - طرحوارها ياز يكسلولخور شيد يحساسي شده بار نگينه
۱۳	شكل ۳-۲ - زمانو نحوه انتقال الکترون در قسمت های مختلف سلول خور شيد يحساسي شده بار نگينه
۱۷	شكل ۴-۲ - چيدمانی يكسلولخور شيد يحساسي شده بار نگينه
۲۱	شكل ۵-۲ - رنگينه هتجاري N719 که از يك زنجير هکربني، يك هسته فلز يو چند سر آزاد تشكيل شده است <i>OH</i>
۲۴	شكل ۶-۲ - شماتيک ياز فرایند سوبده يالکتروفورتيك
۲۴	شكل ۷-۲ - فرایند الکتروفورتيک آنديو كاتدي
۲۶	شكل ۸-۲ - نمايش شماتيک يلا يهيدو گانه و افت پتانسييل در امتداد لا يهيدو گانه، بار سطحي، لا يهيدا سترنولا يهين فوذ ييونها ي بابار مخالف
۳۱	شكل ۹-۲ - توزيع عولت از در امتداد پيلا الکتروشيميا ي باغلظت يو نيبالا، تقریبا تمایياف تو لتأثر در امتداد پيلدر دولا يهيبسياز از کنزيد يكدو الکترو در خميد هد
۳۴	شكل ۱۰-۲ - نمايش شماتيک ياز مکانيز مر سوبناشياز اعوجاجوناز کشنده لا يهيدو گانه الکتريكي
۳۷	شكل ۱۱-۲ - استاندردها يتابخش خور شيد
۴۴	شكل ۱-۳ - دستگاه هلرز شيفرا صوت مور داستفاده هدرا ينپژوهش
۴۵	شكل ۲-۳ - دستگاه همزن فرا صوت مور داستفاده هدرا ينپژوهش
۴۵	شكل ۳-۳ - دستگاه هشبيه ساز نور خور شيد مور داستفاده هدرا ينپژوهش

..... شکل ۳-۴-۳ - شماییاز(الف) آونب) کورهمور داستفاده در اینپژوهش	۴۶
..... شکل ۳-۵-۳ - ترازو مور داستفاده در اینپژوهش	۴۷
..... شکل ۳-۶-۳ - همز نمغنطی سیمور داستفاده در اینپژوهش	۴۷
..... شکل ۳-۷-۳ - منبع تغذیه همور داستفاده در اینپژوهش	۴۸
..... شکل ۳-۸-۳ - ریز سن جمود داستفاده در اینپژوهش	۴۸
..... شکل ۳-۹-۳ pH متر مور داستفاده در اینپژوهش	۴۹
..... شکل ۳-۱۰-۳ - مولتی متر مور داستفاده در اینپژوهش	۴۹
..... شکل ۳-۱۱-۳ - دستگاه پولیشمود داستفاده در اینپژوهش	۵۰
..... شکل ۳-۱۲-۳ - شماییاز میکروسکوپ نوری	۵۰
..... شکل ۳-۱۳-۳ - شماییکسلو خورشید ی حساس شد هبار نگینه از نمایم جاور و اجزای آن	۵۷
..... شکل ۴-۱ - تغییرات pH بر حسب غلظت تید در محلول	۶۳
..... شکل ۴-۲ - تصاویر ماکروسکوپیگرفته شده از سطح پوشش کیلشد هال(الف) بدونید،(ب) ید کم (غلظت تید: ۲۵ میلیگرم بر لیتر)،(ج) ید بهینه (غلظت تید: ۸۵ میلیگرم بر لیتر)،(د) ید زیاد (غلظت تید: ۱۸۰ میلیگرم بر لیتر)،(ه) ید خلیزی زیاد (غلظت تید: ۴۰۰ میلیگرم بر لیتر)	۶۴
..... شکل ۴-۳ - تصاویر میکروسکوپ نوری پوشش TiO_2 (الف) بدونید،(ب) ید کم،(ج) ید بهینه،(د) ید زیاد،(ه) ید خلیزی زیاد	۶۵
..... شکل ۴-۴ - تغییر اتصامات پوشش بر حسب غلظت تید در محلول	۶۶
..... شکل ۴-۵ - تصاویر ماکروسکوپیگرفته شده از سطح پوشش TiO_2 (الف) بدون آب،(ب) آب بهینه (۲۰ میلی لیتر بر لیتر)،(ج) آب زیاد (۴۰ میلی لیتر بر لیتر)،(د) آب خلیزی زیاد (۸۰ میلی لیتر بر لیتر)	۶۸
..... شکل ۴-۶ - تصاویر میکروسکوپ نوری پوشش TiO_2 (الف) بدون آب،(ب) آب بهینه،(ج) آب زیاد،(د) آب خلیزی زیاد.	۶۹
..... شکل ۴-۷ - تغییر اتوزنر سوب تشکیل شده بر حسب ولتاژ اعمالی	۷۲

شكل ٨-٤ - تغييراتضخامتبر حسبوللتاز اعمالی.	٧٣
شكل ٩-٤ - تغييراتوزنرسوبتشكيلشده بهزمانانجامواكنش.	٧٥
شكل ١٠-٤ - تغييراتضخامتبر حسبوللتاز اعمالی.	٧٦
شكل ١١-٤ - تغييراتجريانبر حسبوللتاز سلولحاويفتو آندساخته شده در للتاز ٣٠ ولتوزمان ١ دقيقه.	٧٧
شكل ١٢-٤ - تغييراتجريانبر حسبوللتاز سلولحاويفتو آندساخته شده در للتاز ٣٠ ولتوزمان ٣ دقيقه.	٧٨
شكل ١٣-٤ - تغييراتجريانبر حسبوللتاز سلولحاويفتو آندساخته شده در للتاز ٣٠ ولتوزمان ٨ دقيقه.	٧٩
شكل ١٤-٤ - تغييراتجريانبر حسبوللتاز سلولحاويفتو آندساخته شده در للتاز ٣٠ ولتوزمان ١٢ دقيقه.	٨٠
شكل ١٥-٤ - تغييراتجريانبر حسبوللتاز سلولحاويفتو آندزمان ١، ٨، ٣ و ١٢ دقيقه.	٨٠
شكل ١٦-٤ - تصاویر میکروسکوپیگرفته شده از سطح پوشش شکل شده هalf) زمان ١ دقيقه، ب) زمان ٣ دقيقه، ج) زمان ٨ دقيقه، د) زمان ١٢ دقيقه.	٨٢
شكل ١٧-٤ - فتو آندساخته شده با للتاز ٥ ولتوزمان ٣ دقيقه.	٨٤
شكل ١٨-٤ - تغييراتجريانبر حسبوللتاز سلولحاويفتو آندساخته شده در للتاز ١٠ ولتوزمان ٣ دقيقه.	٨٥
شكل ١٩-٤ - تغييراتجريانبر حسبوللتاز سلولحاويفتو آندساخته شده در للتاز ١٠ و ٣٠ ولت.	٨٦
شكل ٢٠-٤ - تغييراتجريانبر حسبوللتاز سلولحاويفتو آندساخته شده در للتاز ٣٠ ولتوزمان ٣ دقيقه در رنگين همر كرو كروم N719.	٨٧
شكل ٢١-٤ - ساختار و ترکيبي شيميايير نگين همر كرو كروم N719.	٨٩

شكل ٢٢-٤ - تغييرات جريان بر حسب اولتاز سلول حاويفتو آند ساخته شده با اولتاز ١٠ ولتوzman ٣
دقیقه در رنگینه هم کروکر و مدل لحظه اولو ٢٠ ساعت بعد ٩٠

شكل ٢٣-٤ - تغييرات جريان بر حسب اولتاز سلول حاويفتو آند ساخته شده با اولتاز ٣٠ ولتوzman ٣
دقیقه در رنگینه N719 در لحظه اول، ٢ ساعت تو ٢٠ ساعت بعد ٩١